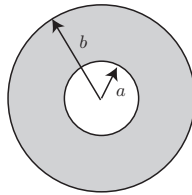


1. 内径 a 、外径 b の無限に長い円筒があり、単位長さあたり $\lambda (> 0)$ の電荷が一様に分布している。(図 1) これによってできる、電場を求めよ。 $r \geq 0$ とし、電場の向きも答えること。誘電率 ϵ_0 は一様とする。

Maxwell 方程式、ガウスの定理を用いてみよ。電荷分布は円筒の軸を中心として回転対称であることに留意し、電場も同じ回転対称性を持つとせよ。¹



2. 静電ポテンシャルが次の形で与えられているとする

$$\phi(r) = \frac{q_0 e^{-kr}}{\epsilon_0 r}$$

ただし、 $k > 0$ 、 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 、 $r = |\mathbf{r}|$

このとき

- (1) 電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ を求めよ。
 - (2) 半径 r より内側の電荷の総量を求めよ。
 - (3) 原点の無限小近傍内での電荷量を求めよ。また全空間の電荷の総量を求めよ
 - (4) 原点以外での電荷密度を求めよ。
 - (5) 原点を除く全空間における電荷の総量を求めよ。この結果と (3) の結果を比較してその整合性を論ぜよ。
3. N 個の電荷 $i = 1, 2, \dots, N$ の電荷を q_i 、位置ベクトルを $\mathbf{r}_i(t)$ 、速度ベクトルを $\mathbf{v}_i(t)$ とする。電荷密度および電流密度は

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \sum_{i=1}^N q_i \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i(t)) \quad \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \sum_{i=1}^N q_i \mathbf{v}_i(t) \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i(t))$$

と表せる。

¹ある解に定数ベクトルを足したのもも解になっている。対称性を要請するとこの任意性がなくなる。

(a) 上の $\rho(\mathbf{r}, t)$ および $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ の定義式に基づき、これらが連続の式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j}$$

を満たしていることを示せ。 $\mathbf{v}_i(t) = d\mathbf{r}_i(t)/dt$ に注意せよ。

(b) (a) の結果から、ある閉じた領域 V に含まれる全電荷 $Q(t)$ の時間変化は

$$\frac{dQ(t)}{dt} = -\int d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j}$$

と表せることを示せ。ただし右辺の面積分は、領域 V を囲む表面とする。

4. 電荷密度を $\rho(\mathbf{r}, t)$ 、電流密度を $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ とする。Maxwell 方程式は、連続の式 (電荷の保存則)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j}$$

と矛盾していないことを示せ。